

## Niegaussowskie procesy stochastyczne

Ćwiczenia 1. i 2.

**Zadanie 1.** Zmienna losowa  $X$  opisana jest przez rozkład prawdopodobieństwa Pareto  $p(x) = \frac{\alpha x^\alpha}{x^{\alpha+1}}$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa zmiennej  $Y = 1/X$ . Sprawdzić unormowanie rozkładu zmiennej  $Y$ .

**Zadanie 2.** Rozkład prawdopodobieństwa głębokości  $\epsilon$  studni potencjału dla pewnego materiału dany jest przez rozkład wykładniczy  $p(\epsilon) = \lambda e^{-\lambda\epsilon}$ . Czas  $\tau$  przebywania cząstki w studni zależy od jej głębokości i dany jest przez  $\tau(\epsilon) = \tau_0 e^{\epsilon/kT}$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa czasu  $\tau$  przebywania w studni potencjału.

**Zadanie 3.** Rozwiązać poprzednie zadanie przy założeniu, że głębokość studni potencjału opisana jest rozkładem normalnym  $N(0, \sigma^2)$ .

**Zadanie 4.** Udowodnić, że rozkład dwumianowy  $B(n, p)$  w granicy  $n \rightarrow \infty$ ,  $p \rightarrow 0$ , przy stałym iloczynie  $np = \lambda$  dąży do rozkładu Poissona. (Twierdzenie Poisson'a)

**Zadanie 5.** Wykazać, że rozkład Poissona dla  $\lambda \gg 1$  oraz  $k \approx \lambda$  (czyli  $k = \lambda(1 + \delta)$ ,  $\delta \ll 1$ ) można opisać rozkładem normalnym  $N(\lambda, \lambda)$ .

**Zadanie 6.** Udowodnić, że rozkład dwumianowy  $B(n, p)$  dla  $n \gg 1$  oraz dla  $k \approx np$  można opisać rozkładem normalnym  $N(np, np(1-p))$ . (Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a).

**Zadanie 7.** Zmienna losowa  $X$  opisana jest przez rozkład normalny standardowy  $N(0, 1)$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa zmiennej  $Y = e^X$ .

**Wskazówka:** przybliżenie Stirlinga  $n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ .

## Niegaussowskie procesy stochastyczne

Ćwiczenia 1. i 2.

**Zadanie 1.** Zmienna losowa  $X$  opisana jest przez rozkład prawdopodobieństwa Pareto  $p(x) = \frac{\alpha x^\alpha}{x^{\alpha+1}}$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa zmiennej  $Y = 1/X$ . Sprawdzić unormowanie rozkładu zmiennej  $Y$ .

**Zadanie 2.** Rozkład prawdopodobieństwa głębokości  $\epsilon$  studni potencjału dla pewnego materiału dany jest przez rozkład wykładniczy  $p(\epsilon) = \lambda e^{-\lambda\epsilon}$ . Czas  $\tau$  przebywania cząstki w studni zależy od jej głębokości i dany jest przez  $\tau(\epsilon) = \tau_0 e^{\epsilon/kT}$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa czasu  $\tau$  przebywania w studni potencjału.

**Zadanie 3.** Rozwiązać poprzednie zadanie przy założeniu, że głębokość studni potencjału opisana jest rozkładem normalnym  $N(0, \sigma^2)$ .

**Zadanie 4.** Udowodnić, że rozkład dwumianowy  $B(n, p)$  w granicy  $n \rightarrow \infty$ ,  $p \rightarrow 0$ , przy stałym iloczynie  $np = \lambda$  dąży do rozkładu Poissona. (Twierdzenie Poisson'a)

**Zadanie 5.** Wykazać, że rozkład Poissona dla  $\lambda \gg 1$  oraz  $k \approx \lambda$  (czyli  $k = \lambda(1 + \delta)$ ,  $\delta \ll 1$ ) można opisać rozkładem normalnym  $N(\lambda, \lambda)$ .

**Zadanie 6.** Udowodnić, że rozkład dwumianowy  $B(n, p)$  dla  $n \gg 1$  oraz dla  $k \approx np$  można opisać rozkładem normalnym  $N(np, np(1-p))$ . (Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a).

**Zadanie 7.** Zmienna losowa  $X$  opisana jest przez rozkład normalny standardowy  $N(0, 1)$ . Znaleźć rozkład prawdopodobieństwa zmiennej  $Y = e^X$ .

**Wskazówka:** przybliżenie Stirlinga  $n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ .